# 碳纳米管薄膜的制备及其宽频域吸光特性研究

李钧颖朱永王宁张洁

(重庆大学光电工程学院光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044)

摘要 利用真空抽滤法制备出具有宽频域吸光性能,且可应用于金属和塑料等多种环境的自支持碳纳米管薄膜 (CNF);利用表面活性剂辅助制备了稳定的碳纳米管分散液,利用真空抽滤法在混合纤维素滤膜上得到了不同厚 度的碳纳米管薄膜,并利用氙灯加热法实现了薄膜的完美分离。结果表明:碳纳米管分散液经真空抽滤后可在滤 膜上形成具有纠缠交错呈平面网状结构的连续均匀各向同性薄膜,薄膜厚度与抽滤碳纳米管沉积量成正比关系; 薄膜的光吸收率随着方阻的增大而增大,实验观察结果与用电磁场理论分析结果相符;350~2500 nm 波段宽频域 的光吸收率为94%~98%,并具有一定的提高空间。

关键词 薄膜;碳纳米管薄膜;真空抽滤法;吸光性能;电磁场理论 中图分类号 O439 **文献标识码** A **doi**:10.3788/CJL201340.s107001

## Research of Preparation and Light Absorption Property in Wide Frequency Region of Nanotube Films

Li Junying Zhu Yong Wang Ning Zhang Jie

(Key Laboratory of Optoelectronic Technology & System, Ministry of Education, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract Self-supporting carbon nanotube films (CNFs) with light absorption in broadband frequency field are prepared by the method of vacuum filtration, and the films can be applied to a variety of environments, such as metal and plastic. Carbon nanotubes aqueous solutions with stable dispersion are prepared with the assist of surfactant. CNFs with different thicknesses are prepared on mixed cellulose membrane filter by vacuum filtration method. Perfect separation of the films is achieved with xenon lamp heating method. The results show that entangled and continuous isotropy CNFs with staggered planar mesh structure are formed from carbon nanotube dispersion solution and the film thickness is proportional to the amount of deposition carbon nanotubes; the light absorption rate increases with the increase of sheet resistance, which is consistent with optical absorption characteristics in electromagnetic field theory. The light absorption rate in the wavelength region of  $350 \sim 2500$  nm is  $94\% \sim 98\%$ , which has certain potential.

Key words thin films; carbon nanotube film; vacuum filtration method; light absorption performance; electromagnetic field theory

OCIS codes 310.6860; 300.1030; 260.2110

1 引 言

由呈六边形排列的碳原子构成的单层或多层同 轴圆管称为碳纳米管(CNT),由多根 CNT 有序或无 序排列所构成的薄膜称为碳纳米管薄膜(CNF)。由 于其优异的电学和光学特性,如高迁移率、载流能力、 柔韧性等独特性质,CNF 可应用于互补金属氧化物 半导体(CMOS)集成电路和高频器件,替代传统硅材 料作为沟道进而提高器件迁移率和抑制短沟道效应, 并且 CNF 能最大限度减小单壁碳纳米管性质、位置、 方向的不均匀性带来的器件性质离散,可以实现中等 规模集成电路应用<sup>[1-4]</sup>,并开始应用于薄膜晶体管、 传感器、透明电极材料以及纳米多孔能源存储等领

作者简介:李钧颖(1992一),女,硕士研究生,主要从事微米/纳米器件及系统等方面的研究。

E-mail: junelioptics@gmail.com.

**导师简介:**朱 永(1973—),男,博士,教授,主要从事光微纳器件及系统、光电仪器等方面的研究。 E-mail: yongzhu@cqu. edu. cn(通信联系人)

收稿日期: 2013-07-01; 收到修改稿日期: 2013-09-01

基金项目:国家自然科学基金(61376121)、中央高校基本科研业务费科研专项(106112013CDJZR120008)

域。近几年,国内也针对碳纳米管的阴极场发射特性 和碳纳米管在脉冲激光器等领域的应用开展了相应 的研究<sup>[5-7]</sup>。2011年,美国宇航局(NASA)的工程师 利用化学气相沉积法(CVD)制备了垂直取向的 CNF,薄膜厚度约为40~100 µm,该取向薄膜实现了 对紫外、可见光、红外以及远红外波段光超过99%的 吸收率,其中一项重要的应用是杂散光抑制:附着在 材料表面的纳米碳管可以收集并阻滞背景光线,从而 阻止其从表面反射出去,降低对需要观测目标光线的 干扰,在航天领域具有广泛的应用前景<sup>[8]</sup>。

CNF的制备方法主要包括 CVD 直接生长法和 溶液法,其中 CVD 直接生长法可用于生长一致/随 机取向的 CNF,但其制备工艺复杂,生长效率低且 成本较高;而溶液法包括电泳法,旋涂法,L-B 法和 真空抽滤法等。其中真空抽滤法被认为是制备由纯 CNT 组成的均匀导电 CNF 最简单的方法<sup>[9]</sup>。该方 法的优点:1)随着薄膜的生长,较厚处的薄膜由于 网孔密集,抽滤速率下降,从而可实现均匀成膜的目 的;2) 在真空抽滤的作用力下,纳米管趋于垂直沉 淀的方式,从而在纳米管之间产生了最大程度的重 叠和渗透,带来了高电导率和机械完整性;3) 薄膜 厚度的可控性。

真空抽滤法是在滤膜上沉淀生长 CNF,在实际 应用时需要将薄膜与滤膜分离,过渡转移至目标基 底上。聚二甲硅氧烷基(PDMS)法为目前最常用的 CNF 分离转移法,该方法利用 PDMS 作为过渡转 移层,利用 PDMS 和 CNF 之间的粘附力将薄膜转 移至 PDMS 上,再将带有薄膜的 PDMS 转移至目标 基底上,并将 PDMS 固化剥离即可完成薄膜的转移 工作<sup>[10-12]</sup>。该方法的突出优点为可制备图形化的 CNF,而缺点则在于转移过程对碳纳米管薄膜的污 染,工艺的复杂性以及目标基底的选择局限性。本 文建立了一种 CNF 的分散、真空抽滤以及滤膜分离 方法,可制备出厚度均匀可控的单独自支持、各向同 性的碳纳米管薄膜,对中红外到紫外宽频域波段均 具有很强的吸光特性。

### 2 实验制备

## 2.1 碳纳米管分散液的制备

真空抽滤法利用真空负压,将 CNT 从溶液中 过滤出来,并在滤膜上形成 CNF。抽滤的效率和薄 膜的成膜质量取决于 CNT 的分散程度,若 CNT 未 完全分散,出现团聚,抽滤效率会降低,且所形成的 薄膜均匀性较差,表面粗糙。因此稳定 CNT 分散 液的制备是真空抽滤制膜的前提。

将购买的羧化(CNT-COOH)和纯化多壁碳纳 米管(中国科学院成都有机化学有限公司)粉末分别 适当研磨并加入去离子水在超声清洗机内预超声分 散1h。加入碳纳米管水分散剂(TNWDIS,中科时 代化学有限公司)作为辅助分散剂继续超声震荡 12h,并间隔4h取样。12h超声震荡样品静置共 72h以检验分散体系的稳定性,间隔12h取样。利 用美国 Brookhaven 公司生产的型号为 90Plus 的激 光散射仪对 CNT 的粒度进行测量。

CNT 分散液中 CNT 等效粒径随超声时间的变 化关系如图 1 所示,预分散 1 h 后 CNT-COOH 分 散颗粒的等效直径为 277.4 nm,添加辅助分散剂后 超声震荡 12 h 降至 205.2 nm。纯化多壁碳纳米管 预分散 1 h 后的等效粒径为 356.7 nm,添加辅助分 散剂后超声震荡 12 h 降至 121.7 nm。TNWDIS 对 于亲水性较好的 CNT-COOH 的辅助分散作用比纯 化 CNT 低,主要是因为前者的羧基削弱了一端是 亲水基,另一端是亲油基表面活性剂的作用。





超声溶液 72 h 的静置实验未发现有絮状物或 沉淀产生,其等效粒径与静置时间的关系如图 2 所



图 2 不同静置时间的等效粒径变化关系 Fig. 2 Relationship between equivalent particle size and standing time

示,等效粒径随着静置时间的延长并未出现明显变 化,只呈现小幅度的动态平衡,说明经过 TNWDIS 辅助超声的碳纳米管分散体系非常稳定。

#### 2.2 真空抽滤法制备碳纳米管薄膜

利用真空泵、布氏漏斗和上嘴滤瓶搭建真空抽滤 系统。采用混合纤维素脂滤膜(MCE),滴加稳定的 CNT 分散液并控制抽滤速度,使 CNT 均匀沉积在滤 膜上,并在 60 °C下烘干。以 TNWDIS 辅助分散的质 量浓度均为 1 mg/mL 的 50、100、150、200 mL 的 CNT-COOH 分散液分别在 MCE 滤膜上沉积了 CNT 含量为 50、100、150、200 mg 的 CNF,如图 3 所示。肉 眼观察 CNF 呈现纯黑色,表面光滑平整。



图 3 MCE 滤膜上不同沉积量的羧化 CNF。(a) 50 mg; (b) 100 mg; (c) 150 mg; (d) 200 mg Fig. 3 Carboxylation CNFs on MCE filters with different deposit amounts. (a) 50 mg; (b) 100 mg; (c) 150 mg; (d) 200 mg

#### 2.3 薄膜与滤膜的分离

PDMS 转移法在分离转移 CNF 和滤膜时,工 艺较为复杂。由于制备的 CNF 较厚,在滴加分散液 时薄膜内部易形成分层结构,层与层之间的附着力 相对较小,在 PDMS 转移时容易破碎断裂,难以分 离出完整均匀的 CNF。

MCE 材料为纤维素酯类,包括硝酸纤维素和醋酸纤维素,也称为硝化纤维,易燃且燃烧生成物大多为气体。而多壁 CNT 燃点则在 600 ℃~700 ℃之间,在空气中 600 ℃以下都非常稳定,二者之间燃点的差别以及 MCE 燃烧气体生成物的特点,决定了燃烧去除 MCE 滤膜的可行性。考虑采用一种缓慢加热,直至 MCE 滤膜燃烧,从而可完整保留 CNF的方法。

CNF 在可见光区域为纯黑体,具有较高的可见 光吸收率。采用模拟太阳光源氙灯加热薄膜和滤膜 基底,数秒内即可见 MCE 滤膜急速完全燃烧,而 CNF 未受到任何影响。分离后的 CNF 可以任意裁 剪或弯曲,可单独使用或转移到其他基底上。图 4 是用此方法与滤膜分离并将圆弧剪裁后的 CNF,分 离后薄膜表面没有任何变化,背面也非常平整,没有





灼烧痕迹,肉眼观察不到燃烧残留物。

## 3 结果及分析

#### 3.1 薄膜的形貌观察

利用日本 KEYENCE 公司的 VHX-500FE 超景 深三维显微系统观察分离后 CNF 横截面,如图 5 所 示,从厚度上观察薄膜平整均匀,测得 CNF 厚度分别 为 10.36、20.90、30.19、39.98 μm,其厚度与沉积碳纳 米管量成正比关系,表现出较好的厚度可控性。



图 5 不同沉积量的 CNF 截面图。(a) 50 mg; (b) 100 mg; (c) 150 mg; (d) 200 mg

Fig. 5 CNF section views with different deposit amounts.(a) 50 mg; (b) 100 mg; (c) 150 mg; (d) 200 mg

利用日本电子株式会社生产的型号为 JSM-7600F 的场发射扫描电子显微镜(SEM)观察 CNF 表面形貌,如图 6 所示。图中可以看到膜内的 CNT 弯曲缠结,形成无序交叠的表面形貌。CNT 的力学 性能较好,单根多壁碳纳米管的抗拉强度可达 150 GPa<sup>[13]</sup>,抽滤过程中纳米管之间的相互缠绕从 而可形成柔软且不易碎裂的薄膜。CVD 法制备的 取向碳纳米管薄膜为从基底直接生长而成的膜,薄 膜厚度一般即为碳纳米管的长度,而抽滤法所制备 的碳纳米管薄膜则展现出面内和面外各向同性的性 质,这对于不同方向杂散光的吸收有利。



图 6 不同沉积量 CNF 的 1×10<sup>6</sup> 倍 SEM 表面形貌。 (a) 50 mg; (b) 100 mg; (c) 150 mg; (d) 200 mg Fig. 6 SEM surface morphology magnified 1×10<sup>6</sup> times of CNF with different deposit amounts. (a) 50 mg; (b) 100 mg; (c) 150 mg; (d) 200 mg

图 7 为与滤膜分离后薄膜正反面的 SEM 形 貌。分离后薄膜与滤膜的接触面展现与正面相同的 高低倍形貌。由于真空抽滤时分散液底部的少量沉 淀难以过滤,并最终沉积在薄膜正面,因此薄膜正面 在低倍观察时略为粗糙,而滤膜接触面则显得较为 光滑平整。在高倍观察时,正反面的 CNT 堆积密 度几乎无区别。说明氙灯燃烧分离法并未对薄膜的 形貌、结构和完整性带来影响。



图 7 分离后 150 mg CNF 的 SEM 图。(a)正面 200 倍; (b)反面 200 倍;(c)正面 30000 倍;(d)反面 30000 倍

Fig. 7 SEMs of separated 150 mg CNF. (a) Front side  $\times 200$ ; (b) back side  $\times 200$ ; (c) front side  $\times 30000$ ; (d) back side  $\times 30000$ 

## 3.2 薄膜的方阻测量

利用苏州百神科技有限公司的 SX1944 型数字 式四探针测试仪测量了 CNF 表面均匀分布九个点 的表面方阻值,测量结果如表1所示。四张薄膜的 九点表面方阻测量结果一致,表明薄膜的厚度与膜 内的 CNT 分布状态均匀。随着薄膜厚度的增加, 表面方阻逐渐降低。

表1 CNF 表面九点方阻值

Table 1 Surface resistances of nine-point on CNF

No.	CNF surface resistance $/\Omega$			
	50 mg	100 mg	150 mg	200 mg
1	66	37	23	15
2	67	36	24	14
3	67	36	24	14
4	68	34	25	14
5	67	35	25	15
6	64	37	23	14
7	68	35	24	16
8	65	35	24	14
9	66	36	25	15
Mean	66.44	35.67	24.11	14.56

#### 3.3 薄膜的宽频域吸光特性

利用美国 Perkin Elmer 公司的 LAMBDA 750UV/VIS/NIR 型分光光度计对不同厚度 CNF 在 350~2500 nm 波长范围内的反射光谱与透射光 谱进行测试,发现薄膜的透射光谱在测试波段近似 为零,因此薄膜的吸收率曲线可视为 100% 与反射 光谱的相减值。

图 8 为所制备不同厚度独立 CNF 的吸收率曲 线图,可以看出 CNF 对光辐射有极强的吸收能力, 并且随着厚度的降低,CNF 对光波的吸收率逐渐升 高,10 μm 薄膜测试波段的吸收率在 94%~98%之 间。4 条曲线在 850 nm 波长处均出现跳变,这与检 测器的切换有关,是测量宽频域光谱特性难以消除 的现象。

从图 8 中可以看到,吸收率并不是随着薄膜厚 度增加而增加的,而是在薄膜厚度增加时减小。4



图 8 不同沉积量 CNF 的吸收光谱 Fig. 8 Absorption spectra of CNF with different deposit amounts

者之间厚度最小的薄膜,即 50 mg CNT 沉积量薄膜 的透射率近似为零,因此可排除透射因素的影响。 一般情况下,厚度的增加可增大薄膜内部光线的传 播距离,能带来更好的光吸收效果,或至少表现出等 同的吸光特性。因此吸收率随着厚度增加而减小的 现象更多与薄膜空气界面处的光学电磁波折射特性 相关。为了描述 CNF 在界面处的光吸收特性,定义 薄膜的复折射率系数为<sup>[14]</sup>

$$\hat{N} = n + \mathrm{i}k = \left[\varepsilon_1 \mu_1 + \mathrm{i} \frac{4\pi\mu_1 \sigma_1}{\omega}\right]^{1/2}, \quad (1)$$

式中 n 为折射率,k 为消光系数。ɛ1 为介电常数,σ1 为 电导率,μ1 为磁导率。折射率为吸收性介质最主要 的光学常数。

复折射系数 Ñ 定义了光波在媒质中的传播特性,而阻抗定义为电磁波中某点电场强度与磁场强度的比值,考虑到电场与磁场相互垂直的关系可得阻抗为

$$\hat{Z}_{\rm S} = \frac{4\pi}{c} \frac{\mu_1}{\hat{N}} = \frac{4\pi}{c^2} \frac{\mu_1 \omega}{\hat{q}} = \frac{4\pi}{c} \left(\frac{\mu_1}{\hat{\varepsilon}}\right)^{1/2}.$$
 (2)

空气阻抗  $Z_0 = 4\pi/c = 4$ . 19 × 10<sup>-10</sup> s · cm<sup>-1</sup> = 377 Ω。

电磁波的阻抗值也被称为表面复阻抗,利用波 矢 q 与频率之间的色散关系可得

$$\hat{Z}_{\rm S} = \frac{4\pi}{c} \left[ \frac{\mu_1}{\varepsilon_1 + \mathrm{i}(4\pi\sigma_1/\omega)} \right]^{1/2} = R_{\rm S} + \mathrm{i}X_{\rm S}, \quad (3)$$

式中 $R_s$ 称为表面阻抗,而虚部 $X_s$ 称为表面电抗。由 于碳纳米管薄膜具有良好的导电特性,因此可假设  $\epsilon_1 \gg 1$ ,可得表面复阻抗为

$$\hat{Z}_{\rm S} \approx \left[\frac{4\pi\omega\mu_1}{c^2 \,\mathrm{i}(\sigma_1 + \mathrm{i}\sigma_2)}\right]^{1/2}.\tag{4}$$

因此表面阻抗和电抗分别为

$$R_{\rm s} = \left(\frac{2\pi\omega\mu_1}{c^2}\right)^{1/2} \left[\frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{1/2} - \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right]^{1/2}, \quad (5a)$$

$$X_{\rm s} = -\left(\frac{2\pi\omega\mu_1}{c^2}\right)^{1/2} \left[\frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{1/2} + \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right]^{1/2}.(5b)$$

对于导电薄膜来说, $\sigma_1 \gg |\sigma_2|$ ,此时薄膜的趋肤深度 可表示为

$$\delta_0 = \left(\frac{c^2}{2\pi\omega\mu_1\sigma_1}\right)^{1/2}.$$
 (6)

同时简化(5)式可得到表面阻抗和电抗为

$$-X_{\rm S} = \frac{1}{\sigma_1} \frac{1}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{1/2}} \approx \frac{1}{\delta_0 \sigma_1} \approx R_{\rm S} - X_{\rm S}.$$
 (7)

将阻抗的公式代入界面处的反射率表达式

$$R = \hat{r}^2 = \left| \frac{\hat{N}' - \hat{N}}{\hat{N}' + \hat{N}} \right|^2 = \left| \frac{\hat{Z}_{\rm s} - \hat{Z}_{\rm s}'}{\hat{Z}_{\rm s} + \hat{Z}_{\rm s}'} \right|^2, \quad (8)$$

式中r为复反射系数, $\hat{N}'$ 表示空气中的复折射率,

Źs表示空气中的阻抗。可得碳纳米管薄膜的反射率 与表面方阻之间的关系式为

$$R = 1 - \frac{4R_{\rm s}}{Z_{\rm o}} \left( 1 + \frac{2R_{\rm s}}{Z_{\rm o}} + \frac{2R_{\rm s}^2}{Z_{\rm o}^2} \right)^{-1}, \qquad (9)$$

对  $R_s$  进行求导,可得到当表面方阻  $R_s = Z_0 / \sqrt{2} = 266 \Omega$  时,光学电磁波在薄膜与空气的界面达到最佳 阻抗匹配,光透射率最大,从而在薄膜界面处的光学 电磁波反射率最小。当表面方阻小于  $266 \Omega$  时,光学 电磁波在界面处的反射率随着电阻的增大逐渐减小。

碳纳米管由于能带的带间跃迁和呼吸振动模从 而具备了紫外、可见光和红外波段的吸收能 力<sup>[15-16]</sup>,厚度大于趋肤深度时,从薄膜界面处入射 至内部的光波均可有效地被衰减吸收。由于(6)式 中磁导率和电导率具有一定的频率色散特性,而这 种频率色散特性较难通过实验直接测得。在估算材 料在不同波段的趋肤深度值时,往往采用另一经验 公式<sup>[17]</sup>,该公式可从材料的静态电导率和磁导率估 算出某频率点下对应的趋肤深度值,利用方阻测量 结果可求得厚度为10、20、30、40  $\mu$ m的CNF,其趋 肤深度分别为74.3、77.1、77.6、69.7 nm,远远小于 薄膜的厚度,从而光波在薄膜上的透射率近似为零。 因此碳纳米管薄膜的吸收率可A=1-R,即

$$A = \frac{4R_{\rm s}}{Z_{\rm o}} \left( 1 + \frac{2R_{\rm s}}{Z_{\rm o}} + \frac{2R_{\rm s}^2}{Z_{\rm o}^2} \right)^{-1}.$$
 (10)

根据(10)式,当方阻小于 266Ω 时,薄膜的吸收 率随着方阻的增大而增大,而 CNT 沉积量减少时, 薄膜厚度逐渐降低,表面方阻逐渐升高,因此吸收率 逐渐增大,这与图 8 中的实验结果相符。提高表面 方阻,可提高 CNF 在宽频域的整体吸收率。

(9)式忽略了薄膜反射率的频率色散关系,并且 建立在薄膜连续体假设的基础上,可用于解释薄膜 与空气界面处的整体反射率变化,但其忽略了薄膜 表面孔洞或颗粒对光波的散射作用。从图 6 电镜照 片可以看出,薄膜的表面存在几十到几百纳米的孔 洞和间隙,其尺寸与入射光波的波长差别相对较小, 特别在可见光和紫外波段。此时光波的表面作用将 包含有孔洞的散射效应,这种散射作用有助于提高 材料对光波的吸收。从图 8 吸收光谱上可以看出, 随着波长的降低,薄膜的光吸收率逐渐增大。因此 针对抽滤法制备的面内/面外各向同性 CNF,提高 其宽频域吸光能力的主要因素可包括:1) 调整薄膜 的表面方阻值,使其表面界面处的光频电磁波达到 阻抗匹配,降低表面的反射率,从而可增大进入薄膜 内部的入射光强度;2) 适当增大表面与波长相当的 孔洞或间隙数量,增大表面的微粗糙度,从而可增大 孔洞的散射效应,增大光波在薄膜表面附近的传播 距离,从而提高光吸收率。

## 4 结 论

在碳纳米管水分散剂的辅助下,利用超声分散 技术制备出粒度分布稳定的碳纳米管分散液,利用 真空抽滤法在 MCE 混合纤维素脂滤膜上制备出不 同厚度的碳纳米管薄膜,利用氙灯模拟太阳光源照 射碳纳米管薄膜,从而加热并燃烧 MCE 滤膜实现 薄膜和滤膜的完美分离。所制备出的薄膜厚度与碳 纳米管沉积量成正比关系,且薄膜厚度均匀。薄膜 内部碳纳米管呈各向同性分布,交错网状结构为形 成连续自支持薄膜的主要原因。

所制备的自支持碳纳米管薄膜在紫外到中红外 波段均具有很强的吸光特性。利用电磁场的基本理 论,计算得出碳纳米管薄膜的吸收率与表面方阻有 关。10 μm 厚薄膜在 350~2500 nm 波段的吸收率 在 94%~98%之间;真空抽滤与薄膜分离方法工艺 简单,成本较低,在太阳能源利用和航天领域具有一 定的工程应用价值。

#### 参考文献

- 1 B H Chen, H C Lin, T Y Huang, *et al.*. Complementary carbon nanotube-gated carbon nanotube thin-film transistor[J]. Applied physics letters, 2006, 88(9): 093502.
- 2 M Kaempgen, C K Chan, J Ma, *et al.*. Printable thin film supercapacitors using single-walled carbon nanotubes [J]. Nano Lette, 2009, 9(5): 1872-1876.
- 3 E S Snow, J P Novak, P M Campbell, *et al.*. Random networks of carbon nanotubes as an electronic material[J]. Applied Physics Letters, 2003, 82(13): 2145-2147.
- 4 E J Bae, Y S Min, U J Kim, et al.. Thin film transistors of single-walled carbon nanotubes grown directly on glass substrates [J]. Nanotechnology, 2007, 18(49): 495203.
- 5 Ye Yun, Guo Tailiang, Lin He, et al.. Effects of electrophoretic

Nano-Ag on field emission properties of CNT cathode[J]. Acta Optica Sinica, 2010, 30(12): 3542-3546.

叶 芸, 郭太良, 林 贺, 等. 电泳纳米 Ag 对碳纳米管阴极场 发射性能的影响[J]. 光学学报, 2010, 30(12): 3542-3546.

6 Qu Zunshi, Ma Baomin, Liu Jie. Research on pulse laser characteristics for 2  $\mu$ m Tm: YAP laser based on carbon nanotube absorber[J]. Chinese J Lasers, 2011, 38(11): 1102009.

曲遵世,马宝民,刘 杰. 基于碳纳米管的 Tm:YAP2 μm 脉冲 激光特性实验研究[J]. 中国激光, 2011, 38(11): 1102009.

7 Jiang Meng, Zhang Weigang, Yan Aidong, *et al.*. Tentative measurement researches on fiber loop ring-down cavity coated with carbon nanotubes [J]. Chinese J Lasers, 2010, 37(6): 1450-1455.

姜 萌,张伟刚,颜爱东,等. 碳纳米管涂覆的光纤环衰荡腔检 测技术的初步研究[J]. 中国激光,2010,37(6):1450-1455.

- 8 J G Hagopian, S A Getty, M Quijada, et al.. Multiwalled carbon nanotubes for stray light suppression in space flight instruments [C]. SPIE, 2010, 7761, 77610F.
- 9 Z Wu, Z Chen, X Du, *et al.*. Transparent, conductive carbon nanotube films[J]. Science, 2004, 305(5688): 1273-1276.
- 10 Q Cao, S H Hur, Z T Zhu, *et al.*. Highly bendable, transparent thin-film transistors that use carbon-nanotube-based conductors and semiconductors with elastomeric dielectrics [J]. Advanced Materials, 2006, 18(3): 304-309.
- 11 M A Seo, J H Yim, Y H Ahn, et al.. Terahertz electromagnetic interference shielding using single-walled carbon nanotube flexible films[J]. Applied Physics Letters, 2008, 93(23): 231905.
- 12 D R Hines, S Mezhenny, M Breban, et al.. Nanotransfer printing of organic and carbon nanotube thin-film transistors on plastic substrates[J]. Applied Physics Letters, 2005, 86(16): 163101.
- 13 B G Demczyk, Y M Wang, J Cumings, et al.. Direct mechanical measurement of the tensile strength and elastic modulus of multiwalled carbon nanotubes [J]. Materials Science and Engineering: A, 2002, 334(1-2): 173-178.
- 14 M Dressel. Electrodynamics of Solids: Optical Properties of Electrons in Matter [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- 15 T Yamabe, K Fukui, K Tanaka. The Science and Technology of Carbon Nanotubes[M]. Oxford: Elsevier Science, 1999.
- 16 M Ichida, S Mizuno, Y Tani, *et al.*. Exciton effects of optical transitions in single-wall carbon nanotubes[J]. J Phys Soc Japan, 1999, 68(10): 3131-3133.
- 17 R H Scott, V A Fassel, R N Kniseley, et al.. Inductively coupled plasma-optical emission analytical spectrometry [J]. Analytical Chemistry, 1974, 46(1): 75-80.

栏目编辑:韩 峰